

Транзисторы 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е для работы в линейных и ключевых схемах

Транзисторы 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е - кремниевые мезапланарные структуры р-п-р составные. Предназначены для применения в усилителях, переключающих устройствах и другой аппаратуре широкого применения.

Транзисторы 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е изготавливаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами КТ-9.

Климатическое исполнение УХЛ.

Масса транзисторов не более 20 г.

- Транзисторы 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В соответствуют техническим условиям аА0.339.054 ТУ.
- Транзисторы КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е соответствуют техническим условиям аА0.336.306 ТУ.

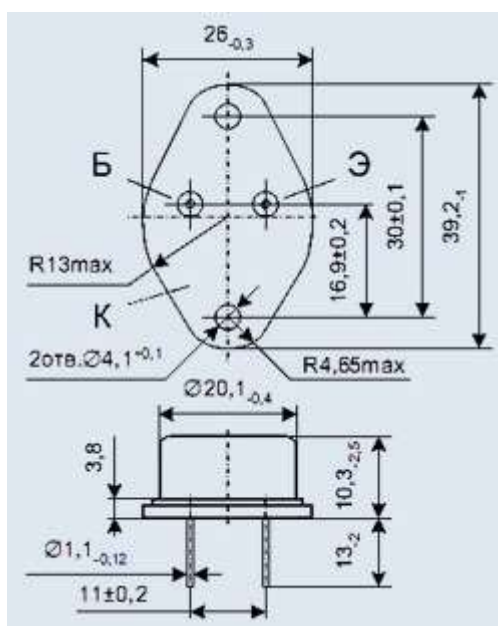


Рис. 1. Габаритные размеры и расположение выводов транзисторов 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е.

Основные технические характеристики транзисторов

Обозначения параметров в таблице:

- $I_{k \max}$ - максимально допустимый постоянный ток коллектора;
- $I_{k, \text{ и } \max}$ - максимально допустимый импульсный ток коллектора;

Параметры				КТ825Г	
$I_k \text{ max, A}$				20	
$I_k, \text{ и } \text{max, A}$				30	
$U_{кэ0} \text{ гр, В}$				70	
$U_{эб0} \text{ max, В}$				5	
$P_k \text{ max, Вт}$				125	
$T_k, ^\circ\text{C}$				25	
$T_p \text{ max, } ^\circ\text{C}$				150	
$T_k \text{ max, } ^\circ\text{C}$				100	
$h_{21Э}$				750	
$U_{кб}, \text{ В}$				10	
$I_{э}, \text{ А}$				10	
$U_{кэ} \text{ нас, В}$				2	
$f_{гр}, \text{ МГц}$				4	
$C_k, \text{ пФ}$				600	
$C_{э}, \text{ пФ}$				600	
$t_{вкл}, \text{ мкс}$				1	
$t_{выкл}, \text{ мкс}$				4,5	
$R_T \text{ п-к, } ^\circ\text{C/Вт}$				1	

- $U_{кэ0} \text{ гр}$ - граничное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы, равном нулю;
- $U_{эб0} \text{ max}$ - максимально допустимое напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю;
- $P_k \text{ max}$ - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора;
- T_k - температура корпуса;
- $T_p \text{ max}$ - максимально допустимая температура перехода;
- $T_k \text{ max}$ - максимально допустимая температура корпуса;
- $h_{21Э}$ - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора;
- $U_{кб}$ - постоянное напряжение коллектор-база;
- $I_{э}$ - постоянный ток эмиттера;
- $U_{кэ} \text{ нас}$ - напряжение насыщения коллектор-эмиттер;
- $f_{гр}$ - граничная частота коэффициента передачи тока;
- C_k - емкость коллекторного перехода;
- $C_{э}$ - емкость эмиттерного перехода;
- $t_{вкл}$ - время включения для биполярного транзистора;
- $t_{выкл}$ - время выключения для биполярного транзистора;
- $R_T \text{ п-к}$ - тепловое сопротивление переход-корпус.

Значения $U_{кэ0} \text{ гр}$... $U_{эб0} \text{ max}$, $h_{21Э}$... $t_{выкл}$ в таблице приведены при $T_p = 25 ^\circ\text{C}$.

Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений - 40000 ч.

Минимальный срок сохраняемости транзисторов при хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированием воздуха, а также транзисторов, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.